تركيب الحقول المغناطيسية:

إذا وجدت عدة حقول مغناطيسية $\overrightarrow{B_1}$ ، $\overrightarrow{B_2}$ ، $\overrightarrow{B_2}$ ، $\overrightarrow{B_1}$ يكون الحقل المغناطيسي المحصّل \overrightarrow{B} هو المجموع الشعاعى لهذه الحقول.

$$\vec{B}_1$$
 \vec{B}_2

 $\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2}$

4 - الكهرومغناطيسية:

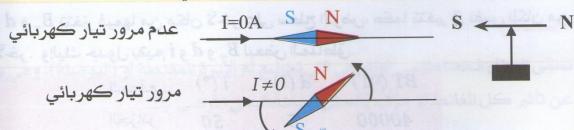
هل أن مرور التيار الكهربائي في ناقل ينشئ حقلاً مغناطيسياً؟ 1 - 4 - 5 مغناطيسياً؟ 1 - 4 - 5 مغناطيسياً؟



في سنة 1820م لاحظ أرستد بمحض الصدفة إنحراف بوصلة كانت موضوعة بجوار سلك ناقل، إثر مرور تيار كهربائي فيه (الوثيقة).

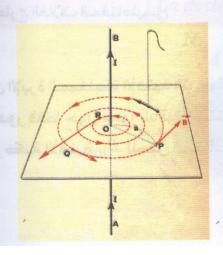
* نتيجة:

كل سلك يمّر فيه تيار كهربائي، يصبح مصدراً لحقل مغناطيسي \vec{B} ، يمكن الكشف عنه ببوصلة. الحقل الكهربائي \longrightarrow الحقل المغناطيسي.



4 - 2 - الحقل المغناطيسي المتولّد عن تيار مستقيم:

تعطى شدة الحقل المغناطيسي B الناشئ عن سلك مستقيم طويل جداً (لا نهائي الطول يجتازه تيار شدته I ثابتة في نقطة معينة تبعد عن السّلك مسافة r بالعلاقة:



[T] : شدة الحقل ب $B=rac{\mu_0\,I}{2\pi\,r}$: شدة التيار ب

البعد العمودي للنقطة المعينة

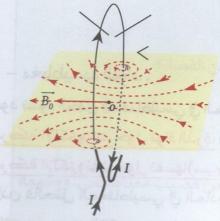
عن السلك ب [m]

نفاذية الفراغ وقيمته μ_o

$$\mu_0 = 4\pi .10^{-7} T.m/A$$

- 3 - الحقل المغناطيسي الناتج عن تيار ملقي:

وحلة حلقة واحدة:



عبارة الحقل المغناطيسي في مركز عبارة الحقل المغناطيسي في مركز عبر المعناطرها R ويجتازها تيار كهربائي I

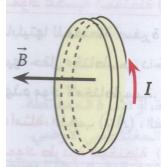
$$B = \mu_0 \frac{I}{2R}$$

ع حالة وشيعة مسطحة:

R لفّه مراصة فيما بينها نصف قطرها N لفّه مراصة فيما بينها نصف قطرها L من طولها L

عدما يجتازها تيار شدته Iثابتة، ينشأ فيها حقل عناطيسي تعطى شدته B، في مركز هذه الوشيعة

$$B = \mu_0 \frac{NI}{2R}$$
 : i.i.



حالة وشيعة طويلة (حلزونية):

- الوشيعة الطويلة هي وشيعة تحتوي على N لفّة غير متراصّة فيما بينها طولها L أكبر مR عف قطرها R .



حقل مغناطيسي. تعطى شدته B ، في مركز هذه

$$B = \mu_0 \frac{NI}{L}$$

وشيعة بالعبارة:



و بالعبارة: $B=\mu_0 nI$ مع $n=rac{N}{2}$ حيث n: عدد اللّفات في وحدة الأطوال. $B=\mu_0 nI$ عن تيار كهربائي $B=\mu_0 nI$ عن تيار كهربائي



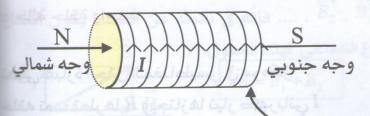


يتم بقاعدتين:

- قاعدة اليد اليمني
- قاعدة رجل آمبير

4 - 5 - تحديد وجهي الوشيعة:

حسب جهة التيار يتغير وجها الوشيعة



5 – مغناطيسية المواد:

يعود نشوء الحقل المغناطيسي في المادة إلى حركة الإلكترونات وهي نوعان:

حركة الإلكتروانت حول نواة الذّرة؛ وتشبه في ذلك تيار كهربائي يسرى في حلقة.

حركة الإلكترونات حول نفسها (سبين SPIN): تبيّن أن كل إلكترون يدور حول نفسه.

- إذن فالحقل المغناطيسي في المادة ناتج عن هذين الدورانين للإلكترونات، غير أن الحقل الناتج عن دوران الإلكترون حول نفسه (سبين) هو حقل كبير جدًّا مقارنة بالحقل الناتج عن دورانه حول النواة. وهكذا نميّز ثلاثة أنواع من المواد:

المواد عكسية المغنطة (M.Dianagnétiques):

قابليتها للمغنطة صغيرة جدًّا أي x < 1 هذه المواد عند وضعها في حقل مغناطيسي ينقف فيها حقل مغناطيسي داخلي، يفنى الحقل المغناطيسي الخارجي.

فهذه مواد لامغناطيسية، بمعنى غير قابلة للتمغنط.

· (Cu) ، النهب (Ag) ، الفضة (Ag) ، النحاس (Cu)

المواد طردية المغنطة (M.Paramagnétiques):

قابليتها المغناطيسية موجبة لكنها أصغر من الواحد x < 1 لها عزوم مغناطيسية دائمة لكن محّصلتها معدومة.

المنيوم (Al)، البلاتين (Pt)، المنغانيز (Mn). همثل: الألمنيوم M

المواد حديدية المغنطة (<u>M.Ferromagnétiques</u>):

قابليتها المغناطيسية 1<< × إذا وضعت في حقل مغناطيسي خارجي، فإنها تتمغنط، وتحافظ على مغنطتها حتى بعد إنعدام الحقل المغناطيسي الخارجي، فهي دائمة المغنطة.

وهذه المواد تفقد مغنطتها عند رفع درجة حرارتها إلى درجة حرارة معينة تسمّى درجة حرارة معينة تسمّى درجة حرارة كوري (Curie).

وكل مادة لها درجة حرارة كوري خاصة بها فمثلا الحديد درجة حرارة كوري له تساوى $(770^{\circ}c)$.